



1060nm 近红外增强硅雪崩光电二极管

产品说明

所述 C30954EH, C30955EH 和 C30956EH 是采用双扩散“穿透”结构的通用硅雪崩光电二极管。这些光电二极管的设计是长波响应（即>900 纳米）已得到增强，而不会引入任何不良属性。

这些 APD 在 1060 纳米有高达 40% 的量子效率。同时，该二极管保持低噪声，低电容，以及快速的上升和下降时间特性。

为了帮助简化许多设计需要，这些 APD 也在 Excelitas 的高性能混合前置放大器模块类型 C30659 系列可用，以及前置放大器和 TE 冷却器并入模块类型 LLAM 系列。请参考相应的部分本产品目录中。

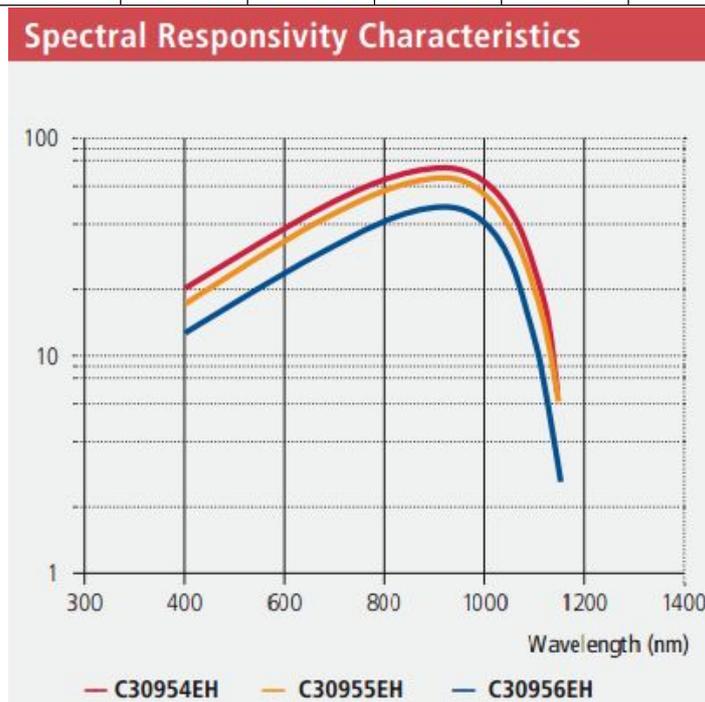
特征和优点

- 在 1060nm 高量子效率
- 快速响应时间
- 工作温度范围宽
- 低结电容
- 密封包装
- RoHs 认证

应用

- 测距
- 激光雷达(光探测和测距)
- YAG 激光检测

近红外增强硅雪崩光电探测器								
Partnumber	Photon Sensitive Diameter	Respon-sivity @1060nm	Dark current	Spectral noise current	capacitance @100KHz	Response Time	NEP@ 1060nm	Vop Range
unit	mm	A/W	nA	pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	pF	ns	fW / $\sqrt{\text{Hz}}$	V
C30954EH	0.8	36	50	0.5	2	2	14	275-425
C30955EH	1.5	34	100	0.5	3	2	15	275-425
C30956EH	3.0	25	100	0.5	10	2	20	275-425



Package Drawing – C30954EH, C30955EH

